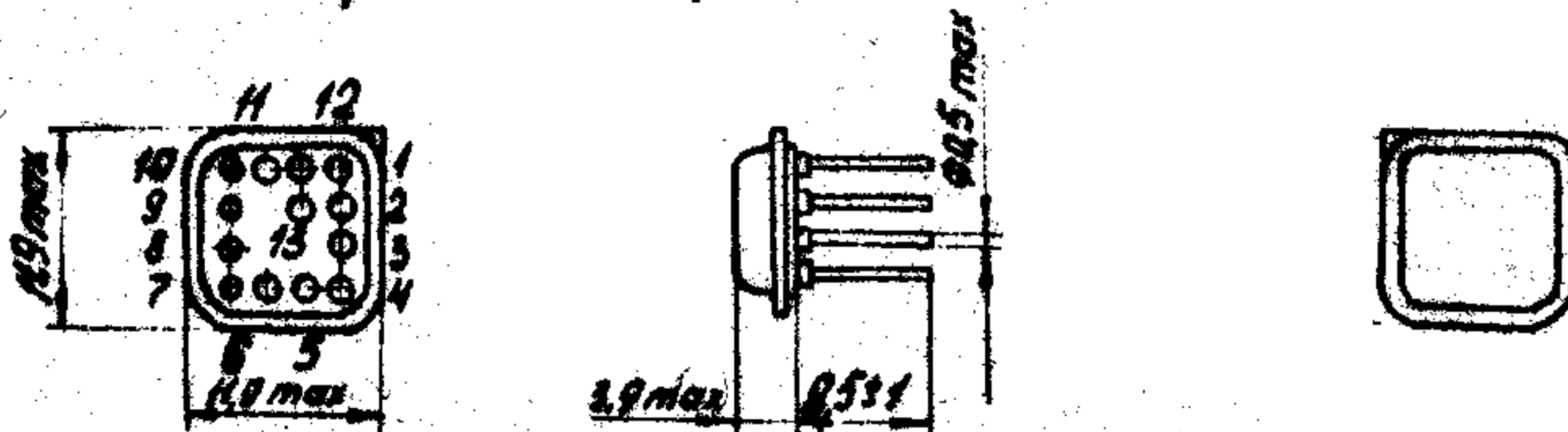




Паспорт

Микросхемы типа К217НТ1, К217НТ2, К217НТ3
соответствуют техническим условиям ОУД. 348. 04 ТУ.

1. Функциональное назначение - транзисторная сборка.
2. Габаритный чертеж:



3. Основные электрические параметры при $T = +25 \pm 10^\circ\text{C}$:

Наименование параметра, единица измерения	К217НТ1	К217НТ2	К217НТ3
Обратный ток коллектора $I_{сб0}$, мкА	≤ 10	≤ 60	≤ 10
Напряжение между коллектором и эмиттером в режиме насыщения $U_{сб sat}$, В	$\leq 0,33$	$\leq 0,33$	$\leq 0,33$
Статический коэффициент передачи тока $\beta_{ст}$	$30 \div 90$	$60 \div 150$	$70 \div 200$
Время рассасывания t_z , нс	≤ 25	≤ 25	≤ 25

4. Указание содержания драгоценных металлов:
см. штамп "Содержит драгоценные металлы".

5. Указания и рекомендации по установке, монтажу и эксплуатации:

а) Рекомендации по пуску методом погружения в расплавленный припой:
температура расплавленного припоя, $^\circ\text{C}$, не более 250
время погружения, с, не более 3
расстояние от корпуса до зеркала припоя (по длине вывода), мм, не менее 1
допустимое количество погружений, не более 2
интервал между двумя погружениями, мин, не менее 5
припой и флюсы по нормам ОУД. 348. 04 ТУ.

б) Рекомендации по установке:

Установку микросхем на плату производят с зазором $1 \div 1,5$ мм.
Крепление микросхем к печатной плате в аппаратуре должно быть произведено методом припайки к выводам без какого-либо механического крепления.

в) Рекомендации по пайке микросхем одноканальным паяльником:

температура жала паяльника, $^\circ\text{C}$, не более 280
время касания каждого вывода, с, не более 3
расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода), мм, не менее 1
интервал между пайками соседних выводов, с, не менее 10
Жало паяльника должно быть заземлено.

г) Рекомендации по групповой пайке:

температура расплавленного припоя, $^\circ\text{C}$, не более 265
время воздействия этой температуры (одновременное на все выводы), с, не более 3
расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода), мм, не менее 1
интервал между двумя повторными пайками выводов, мин, не менее 5

Примечание. При пайке или сварке выводов следует принимать меры, исключающие тепловые, электрические и механические повреждения микросхем.

д) Рекомендации по очистке от флюса, влагозащита:
рекомендуется применять для очистки от флюса жидкость в соот-

В соответствии с нормалью НО.054.083;
рекомендуется для влагозащиты применять лак УР-231,
ТУ6-10-863-76, или ЭП-730, ГОСТ 20824-75

Примечание. Для очистки от флюса и влагозащиты микросхем допускается применять любые другие моющие жидкости и лаки, не оказывающие вредного химического воздействия на покрытие, маркировку и материал корпуса, после согласования со специализированной организацией по применению интегральных микросхем и проведения соответствующих испытаний.

6. Условия эксплуатации.

температура окружающей среды от минус 45 до плюс 70°C;
относительная влажность воздуха 98% при температуре $T=+25^{\circ}\text{C}$;
вибрация с ускорением до 10g в диапазоне частот от 1 до 600 Гц;
многократные удары с ускорением до 75g;
линейные (центробежные) ускорения до 25g.

7. Время наработки 10000 ч.

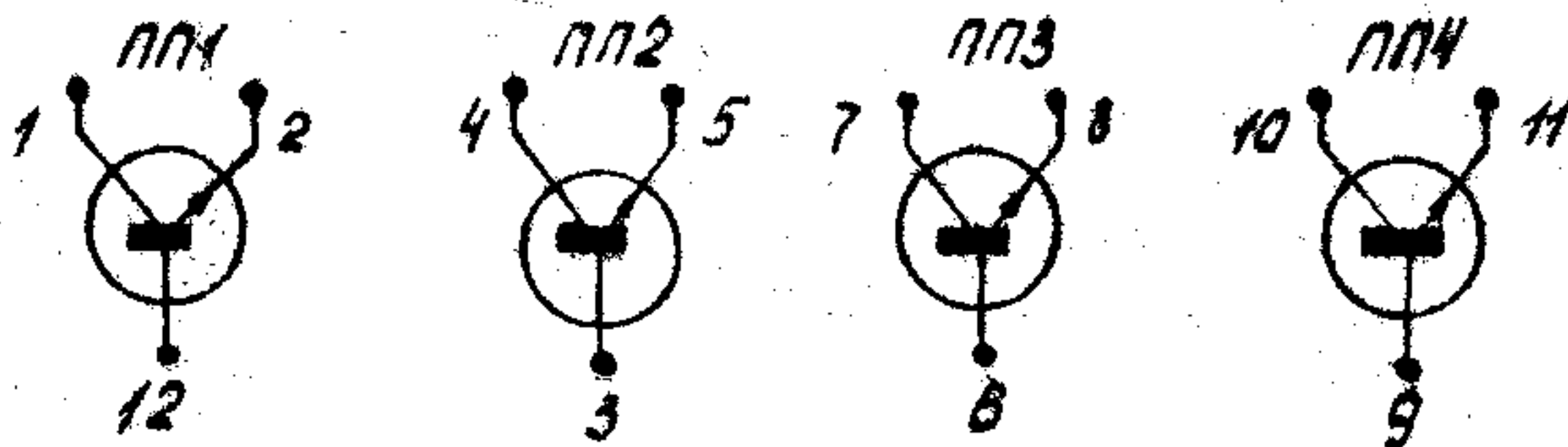
8. Срок хранения 6 лет.

9. Гарантии предприятия-изготовителя.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие каждой поставляемой микросхемы всем требованиям ГОСТ 18725-73 и ТУ в течение срока сохраняемости или наработки при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения и транспортирования, а также указаний по применению, монтажу и эксплуатации установленных ГОСТ 18725-73 ТУ.

Срок гарантии исчисляется со дня отгрузки микросхем потребителю.

10. Схема принципиальная электрическая.



Вариант 1

К217НТ1-ПП1-ПП4 - транзистор кремниевый 2Т318Г или 2Т318А
К217НТ2-ПП1-ПП4 - транзистор кремниевый 2Т318Д или 2Т318Б
К217НТ3-ПП1-ПП4 - транзистор кремниевый 2Т318Е или 2Т318В, В1

Вариант 2.

К217НТ1-ПП1-ПП4-транзистор кремниевый 2Т333Г или 2Т333А
К217НТ2-ПП1-ПП4-транзистор кремниевый 2Т333Д или 2Т333Б
К217НТ3-ПП1-ПП4-транзистор кремниевый 2Т333Е или 2Т333В, В1

Вариант 2 обозначается треугольником цвета маркировки.

11. Масса микросхемы не более 1,5г.

12. Дата выпуска

9.9 ПЕК 1978 тамп-ОТК

